

# Siliziumcarbid, dunkel

Siliziumcarbid wird in elektrischen Widerstandsöfen nach dem Acheson-Verfahren hergestellt, wobei nur schadstoffarme Rohmaterialien, Petrolkoks und Quarzsand zur Verwendung kommen. Die sehr wichtige Sortierung der SiC-Rohstücke erfolgt nach Kriterien wie Farbe,

Kristallausbildung und Reinheit. Die sortierten Rohstücke werden mit Spezialmaschinen weiter zerkleinert, gemahlen und in einzelne Körnungen klassiert. Die danach vorliegenden Einzelkörnungen entsprechen den Anforderungen der FEPA- Norm.

## Anwendung:

Siliziumcarbid wird für die Herstellung von Schleifkörpern und als loses Korn zum Läppen und Polieren eingesetzt.

## Allgemeine Eigenschaften

## SiC dunkel

Kristallstruktur:

überwiegend  $\alpha$ - SiC in den hexagonalen und rhomboedrischen Klassen des hexagonalen Systems.

Spez. Gewicht:

ca. 3,21 g/cm<sup>3</sup>

Härte nach Mohs:

ca. 9,5

Schmelzpunkt:

kein Schmelzen; ca. 3070° C  
thermische Dissoziation

Wärmeleitfähigkeit

ca. 41 W/m K bei Raumtemperatur  
ca. 15 W/m K bei 1673 K

## Typische chemische Analyse in Gew.-% (von Korn 24):

	SiC	C frei	SiO <sub>2</sub>	Si frei	magn.Fe
SiC dunkel	98,6	0,15	0,60	0,50	0,04

**Verfügbare Körnungen:**

F 10 – F 2000

**Lieferform:**

25 kg Säcke, Paletten à 1000 kg